

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ F-ЦЕНТРОВ В ЧИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ

Л. И. РОЩИНА, И. Я. МЕЛИК-ГАЙКАЗЯН, Э. П. КУРАКИНА, Ю. В. ВОЛКОВ

(Статья представлена научным семинаром лаборатории  
радиационной спектроскопии НИИ ФТТ)

Кинетика накопления F-центров на дорадиационных дефектах зависит от элементарных процессов образования и разрушения центров окраски и может быть описана уравнением [1, 2, 3]

$$n_i = \frac{N_1 b_1}{b_1 + \beta_1} [1 - e^{-(b_1 + \beta_1)t}] = n_1 (1 - e^{-B_1 \cdot t}), \quad (1)$$

$$B_1 = b_1 + \beta_1,$$

где  $n_i$  — концентрации F-центров в некоторый момент времени  $t$ ;

$N_1$  — концентрация дефектов в кристалле до облучения, которые могут быть превращены в F-центры (плотность источника);

$b_1$  — вероятность локализации электронов на дорадиационных вакансиях;

$\beta_1$  — вероятность радиационного разрушения F-центров.

При достаточно большом времени и малой интенсивности облучения концентрация F-центров достигает предельной величины.

$$n_i = \frac{N_1 \cdot b_1}{b_1 + \beta_1} = \frac{N_1}{1 + \beta_1/b_1}. \quad (1a)$$

Из литературных данных [4—11] известно, что введение в кристалл металлических примесей может существенно увеличивать предельную концентрацию F-центров, накапливаемых на первой стадии, а при больших содержаниях примесей уменьшать.

Введение в щелочногалоидные кристаллы различных примесей оказывает существенное влияние на концентрацию F-центров, увеличивая исходную дефектность кристалла  $N_1$ . Кроме того, изменение условий локализации дырок и электронов может сказаться на величине вероятности локализации электронов на анионных вакансиях ( $b_1$ ) и радиационном разрушении F-центров ( $\beta_1$ ).

Целью настоящей работы является определение из экспериментальных кривых накопления F-центров вероятностей элементарных процессов их образования и разрушения для кристаллов KCl «чистых» и KCl с добавками Pb<sup>++</sup>, Sr<sup>++</sup>.

Кристаллы KCl, чистые и с примесями, выращивались из расплава по методу Киропулоса из соли марки «хч.». Примеси добавлялись в расплав в виде солей PbCl<sub>2</sub>, SrCl<sub>2</sub>. Из слитков монокристаллов выкалывались образцы строго одной толщины 0,5 мм и облучались на рентге-

новской установке УРС-70, трубка с *Mo*-анодом, напряжение 42 кв, ток варьировался от 4 до 14 мА для изменения интенсивности падающего излучения. Спектры поглощения измерялись на спектрофотометре СФ-4А.

Для нахождения параметров уравнения (1) из экспериментальной кинетической кривой накопления *F*-центров по методу наименьших квадратов была составлена программа расчета на электронно-вычислительной машине «Минск-1».

Сущность методики расчета [3] заключается в следующем.

Требуется найти значения  $n_1$  и  $B_1$ , приводящие к минимуму сумму квадратов отклонений экспериментальных точек от теоретической зависимости (невязка),

$$A_0(n_1 \cdot B_1) = \sum [n_i - n_1(1 - e^{-B_1 \cdot t_i})]^2 = \min. \quad (2)$$

Введем следующие обозначения:

$$x = \{x_1, x_2\} \equiv \{n_1 B_1\}, \quad (3)$$

а также

$$\frac{\partial A_0(x)}{\partial x_i} = A_{i0}(x); \quad \frac{\partial^2 A_0(x)}{\partial x_i \partial y_i} = A_{ij}(x); \quad (i = 1, 2; j = 0, 1, 2). \quad (4)$$

Тогда решение уравнения (2) эквивалентно решению системы

$$A_{i0}(x) = 0, \quad (i = 1, 2). \quad (5)$$

Эта система может быть решена с помощью итерационного метода Ньютона [9]

$$x^{m+1} = x^m - A_x^{-1}(x^m)A(x^m), \quad (6)$$

где  $A(x^m) \equiv \begin{pmatrix} A_{10} \\ A_{20} \end{pmatrix}$ , а матрица  $A_x^{-1}(x^m)$  есть обратная матрице

$$A_{ij} = \begin{pmatrix} A_{11}A_{12} \\ A_{21}A_{22} \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\left\{ \begin{array}{l} n_1^{(m+1)} = n_1^m - \frac{\begin{vmatrix} A_{10}^m & A_{12}^m \\ A_{20}^m & A_{22}^m \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A_{11}^m & A_{12}^m \\ A_{21}^m & A_{22}^m \end{vmatrix}}, \\ B_1^{(m+1)} = B_1^m - \frac{\begin{vmatrix} A_{11}^m & A_{10}^m \\ A_{21}^m & A_{20}^m \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A_{11}^m & A_{12}^m \\ A_{21}^m & A_{22}^m \end{vmatrix}}. \end{array} \right. \quad (7)$$

Если ввести согласно (2—4) матричные компоненты в явном виде, то получим:

$$\begin{aligned} A &= \Sigma \omega_i \varphi_i \\ A_{11} &= \omega_{11} \\ A_{12} &= A_{21} = \Sigma (n_1 \xi_i - \omega_i) \varphi_i \\ &\quad (n_1 t_i \varphi_i \omega_i + n_1^2 \varphi_i^2), \end{aligned} \quad (a)$$

где в целях удобства и сокращения записи принято

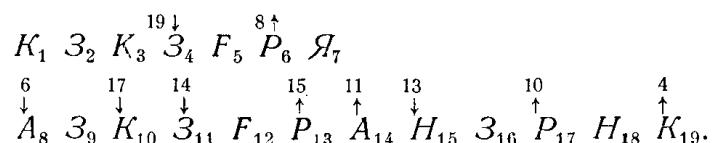
$$\begin{cases} \xi_i = 1 - e^{-B_i t_i} \\ \varphi_i = t_i e^{-B_i t_i} \\ \omega_i = n_i - n_1 \xi_i. \end{cases} \quad (76)$$

Суммирование проводим по всем экспериментальным точкам заданной кривой.

Блок-схема организации программы приведена на рис. 1.

Вначале осуществляется ввод программы блок (1) и проводится контрольное суммирование (2). Если контрольная сумма совпадает с известной, то следует ввод исходных данных (3); если нет, то программа вводится заново, до тех пор, пока не будет получена известная контрольная сумма. После ввода исходных данных они также суммируются (4) и проверяется контрольная сумма. Если контрольная сумма не совпадает, то осуществляется повторный ввод исходных данных; если же контрольная сумма совпадает, то осуществляется перевод введенных десятичных чисел в двоичную систему (5). Далее управление передается основной программе.

Операторная схема программы, осуществляющей обсчет серии экспериментальных кривых, имеет следующий вид:



Здесь  $K_1$  — занесение первоначального вида команды засылки  $N_i$  оператора  $Z_9$  в стандартную ячейку;  
 $Z_2$  — засылка нуля в счетчик числа кривых;  
 $K_3$  — занесение первоначального вида команд оператора  $Z_4$ ;  
 $Z_4$  — засылка параметров  $n_1$  и  $B_1$  в рабочие ячейки;  
 $F_5$  — переадресация команд оператора  $Z_4$ ;  
 $P_6$  — проверка на окончание цикла по числу обсчитываемых кривых (если условие выполнено, то управление передается оператору  $Ya_7$ , если нет, то  $A_8$ );  
 $Ya_7$  — остановка при окончании обсчета всей серии кривых;

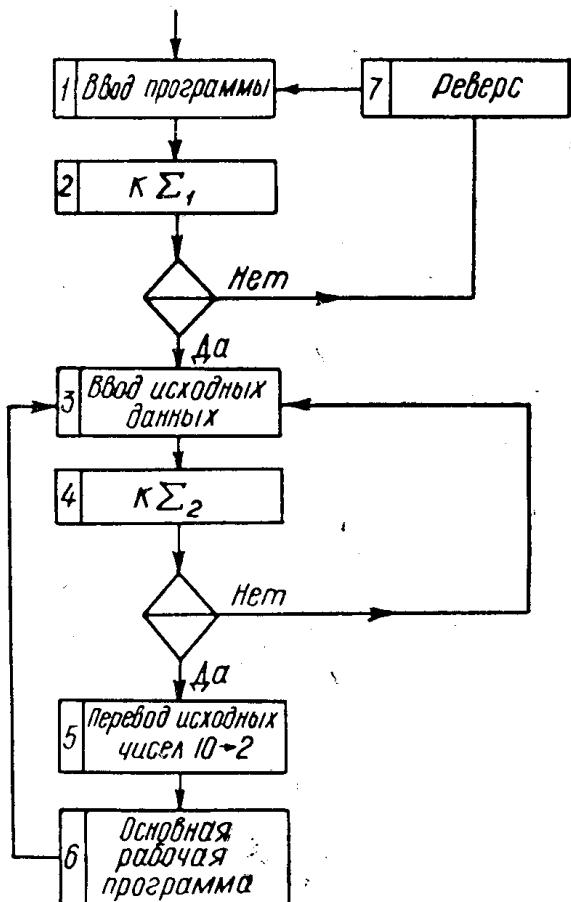


Рис. 1. Блок-схема организации программы

- $A_8$  — добавление единицы в счетчик числа кривых и выдача на печать порядкового номера кривой;  
 $Z_9$  — засылка нулей в ячейки, где накапливаются суммы  $A_{ij}$ ;  
 $K_{10}$  — занесение первоначального вида команд оператора  $Z_{11}$  в цикле по  $x_i$ ;  
 $Z_{11}$  — засылка чисел  $n_i t_i$  очередной кривой в стандартные рабочие ячейки;  
 $F_{12}$  — переадресация команд оператора  $Z_{11}$ ;  
 $P_{13}$  — проверка условия на конец цикла по  $t_i$  (если условие выполнено, то осуществляется переход к оператору  $H_{15}$ , а если условие не выполнено, то к оператору  $A_{14}$ );  
 $A_{14}$  — вычисление  $A_{ij}$ , по формулам (7а, 7б) и переход к оператору  $Z_{11}$ ;  
 $H_{15}$  — вычисление и печать  $x^m$  и невязки;

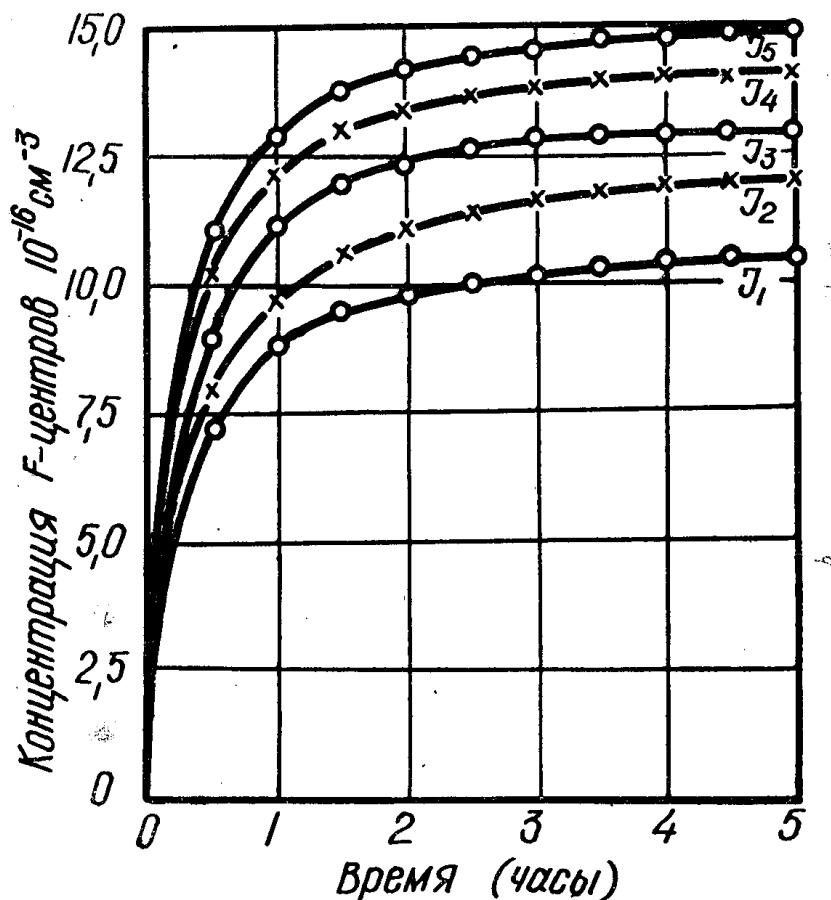


Рис. 2. Кинетические кривые накопления  $F$ -центров в кристаллах  $\text{KCl} + 1,5 \cdot 10^{-3}$  мол%  $\text{PbCl}_2$  при различных интенсивностях рентгеновых лучей  $I_1 : I_2 : I_3 : I_4 : I_5 = 1 : 1,5 : 2 : 2,5 : 3$

- $Z_{16}$  — засылка значений  $x^m$  в ячейки, где находились  $x^{m-1}$ ;  
 $P_{17}$  — проверка условия  $\Delta x^m = x^m - x^{m-1} < \varepsilon$  (если условие выполнено, то осуществляется переход к оператору  $H_{18}$ , если нет, то к  $K_{10}$ );  
 $H_{18}$  — выдача на печать таблицы функции с расчетными параметрами;  
 $K_{19}$  — занесение команды засылки  $n_i$  в промежуточную ячейку для восстановления, переход к оператору  $Z_4$ .

Исходные данные для каждой серии кривых размещаются в памяти следующим образом: каждое число в двоично-десятичном коде записывается в пару ячеек в последовательности: порядок и мантисса чисел.

Приближенные значения параметров  $n_i$  и  $B_i$  каждой кривой располагаются в порядке чередования в первой группе ячеек. Во второй группе расположены значения  $t_i$ , которые полагаются одинаковыми для всех кривых заданной серии. В третьей группе ячеек расположены параметры  $n_i$  в следующем порядке: вначале помещается набор  $n_i$  для первой кривой, затем набор  $n_i$  для второй кривой и т. д.

Время счета одной итерации составляет 4—6 сек, время печатания таблицы значений вычисленных функций — порядка 20—30 сек.

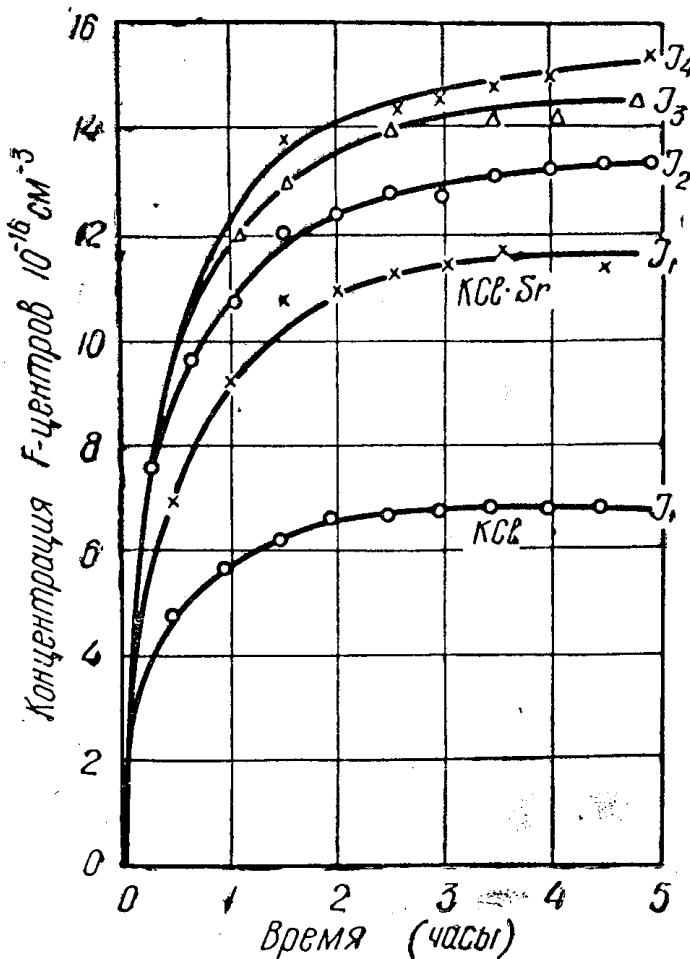


Рис. 3. То же для кристаллов  $\text{KCl} + 3 \cdot 10^{-3}$  мол %  $\text{SrCl}_2$

В процессе работы программы печатаются:

- 1) номера обсчитываемых кривых;
- 2) суммы квадратов отклонения теоретической кривой от экспериментальной (невязка), вычисляемые на каждой стадии итерации;
- 3) промежуточные и окончательные значения  $n_i$  и  $B_i$ ;
- 4) таблица функций с вычисленными наилучшими (минимальное значение невязки) параметрами  $n_i$  и  $B_i$ .

Для определения параметров уравнения (1) нами были получены кинетические кривые накопления  $F$ -центров при изменении интенсивно-

сти падающего излучения. На рис. 2 и 3 представлены кинетические кривые накопления  $F$ -центров в кристаллах  $KCl \cdot Pb$  и  $KCl \cdot Sr$  при различных интенсивностях рентгеновских лучей. Для «чистого» кристалла  $KCl$  соотношение кинетических кривых аналогично и здесь не приводится, только для сравнения на рис. 3 приведена кинетическая кривая накопления  $F$ -центров для  $KCl$  для интенсивности  $J_1$ .

По методу, описанному выше, вычислялись параметры кривой уравнения (1). Из определения параметра  $N_1$  следует, что величина его не зависит от интенсивности, поэтому, построив зависимость  $n_1$  от интенсивности, можно найти величину  $N_1$ , а затем  $b_1$  и  $\beta_1$ .

Результаты вычислений параметров  $B_1$ ,  $b_1$  и  $\beta_1$  кристаллов  $KCl$ ,  $KCl \cdot Pb$  и  $KCl \cdot Sr$  представлены на рис. 4 и 5 в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения. Из рис. 4 и 5 следует, что  $\beta_1$  и  $b_1$  увеличиваются с увеличением интенсивности, так как вероятность локализации электронов на анионных вакансиях пропорциональна числу

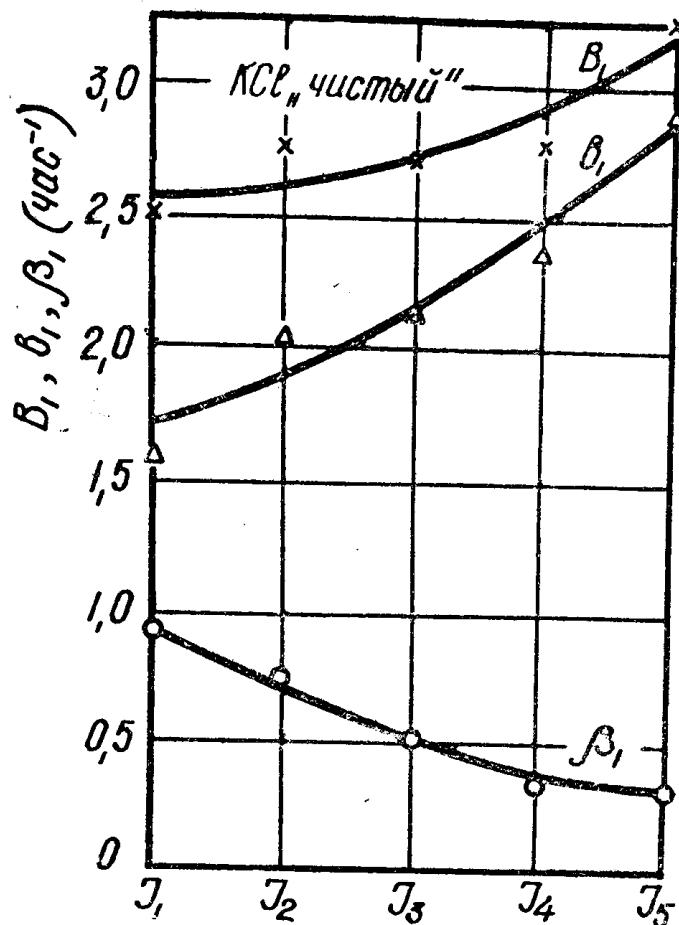


Рис. 4. Зависимость параметров  $B_1$ ,  $b_1$ ,  $\beta_1$  кинетических кривых накопления  $F$ -центров в  $KCl$  от интенсивности рентгеновых лучей

электронов в зоне проводимости [1], которое растет с увеличением интенсивности рентгеновского излучения. В то же время параметр  $\beta_1$  вначале несколько уменьшается с увеличением интенсивности, а затем остается практически постоянным при больших интенсивностях. Митчелл с сотрудниками [1], использовавший рентгеновские лучи высокой интенсивности, не получил изменения  $\beta_1$  от  $J$ , однако в работе [10] этих же авторов имеется указание на увеличение  $\beta_1$  при малых интенсивностях

излучения. Причина такой сложной зависимости величины  $\beta_1$  от  $J$  в настоящее время еще не выяснена.

При введении в кристалл KCl ионов  $Pb^{++}$  наблюдается некоторое уменьшение вероятности локализации электронов на анионной вакансии за сек. Это связано с тем, что добавление электронно-акцепторной примеси обусловливает появление «атомарных» примесных центров, конкурирующих в захвате электронов с анионными вакансиями, и, как следствие этого, уменьшение  $\beta_1$ . Улучшение условий локализации электронов на активаторных уровнях, сопровождается уменьшением вероятности рекомбинации электронов и дырок, тем самым увеличивается концентрация свободных дырок. Эти нелокализованные дырки могут разрушать F-центры [11], параметр  $\beta_1$  увеличивается.

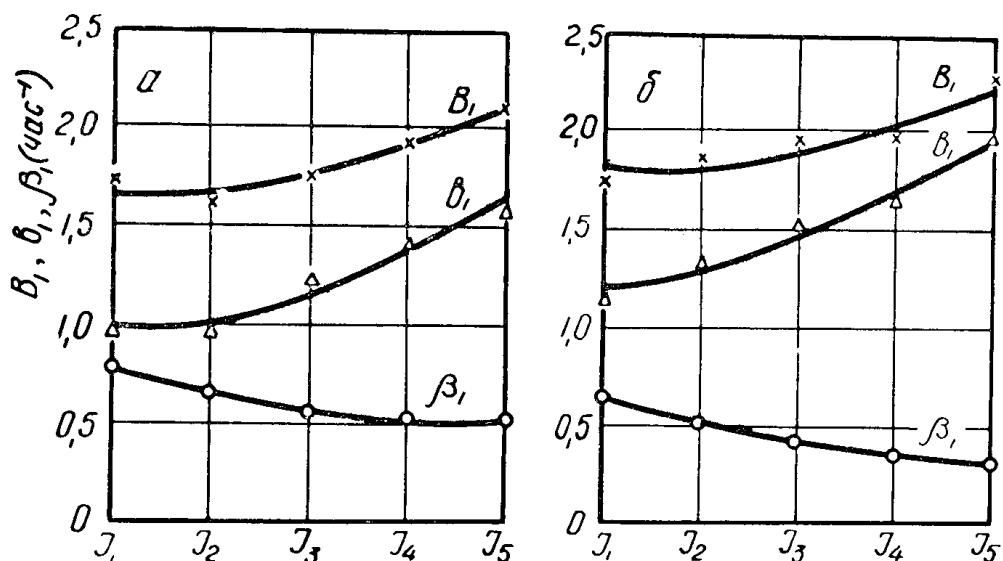


Рис. 5. То же для кристаллов  $KCl + 1.5 \cdot 10^{-3}$  мол %  $PbCl_2$  (а) и  $KCl + 3 \cdot 10^{-3}$  мол %  $SrCl_2$  (б)

В кристалле  $KCl \cdot Sr$  улучшены условия локализации дырок за счет их взаимодействия с комплексами  $Sr^{++} V^+$  с последующим образованием центров Хейса-Никольса [12, 13]. Преимущественная локализация дырок на комплексах  $Me^{++} V^+$  в  $KCl \cdot Sr$  подтверждается уменьшением в этих кристаллах эффекта радиационного понижения ионной электропроводности [14]. Этот процесс сопровождается увеличением устойчивости F-центров в поле радиации (параметр  $\beta_1$  — уменьшается).

#### ЛИТЕРАТУРА

1. P. Mitchell, D. Wiegend, R. Smoluchowski Phys. Rev. 121, 484, 1961.
2. Д. И. Вайсбурд, И. Я. Мелик-Гайказян, Л. И. Рошина. ФТТ, (в печати).
3. Д. И. Вайсбурд. Кандидатская диссертация. Томск. 1965.
4. D. Schulman J. Phys. Chem. 57, 8, 1953.
5. E. E. Schneider Disc. Far. Soc. 31, 176, 1961.
6. Л. М. Шамовский. ДАН СССР, 99, 235, 1954.
7. М. Л. Кац, Б. З. Семенов. Физика щелочногалоидных кристаллов. Труды II Всесоюзного Совещания 1961, 191, Рига, 1962.
8. Ч. Б. Лущик. Тр. ИФА АН ЭССР № 3, 3, 1955.

9. И. С. Березин, Н. П. Жирнов. Методы вычислений, т. 2, Физматиздат, 1962.
10. P. V. Mitchell, D. A. Wiegand, R. Smoluchowski. Phys. Rev. **117**, 442, 1950.
11. И. А. Парфянович. Материалы VII совещания по люминесценции, 1958 г.
12. W. Hayes, G. M. Nichols Phys. Rev. **117**, 993, 1960.
13. W. Hayes J. Appl. Phys., Suppl. **33**, 329, 1962.
14. И. Я. Мелик-Гайказян, Е. К. Завадовская, М. И. Игнатьева. ФТТ, 6, в. 4, 1964.